

性能特点：

- RF/LO 频段：8.5GHz~13.5GHz
- IF 频段：DC-3GHz
- 变频损耗：9.5dB
- RF-IF 隔离度：35dB
- LO-IF 隔离度：22dB
- LO-RF 隔离度：40dB
- 镜频抑制度：30dB
- 本振功率：15dBm
- 芯片尺寸：1.85mm×1.14mm×0.1mm

产品简介：

HH-MX521-G 是一种 GaAs MMIC I/Q 混频器，射频/本振频率分别覆盖 8.5-13.5GHz，中频频率覆盖 DC-3.5GHz，变频损耗小于 9dB，镜频抑制度大于 26dB，射频到中频隔离度大于 34dB，本振到中频隔离度大于 19dB，本振到射频隔离度大于 39dB，典型本振输入功率为 15dBm。

电参数： (TA=25°C,IF=0.1GHz,LO=15dBm)

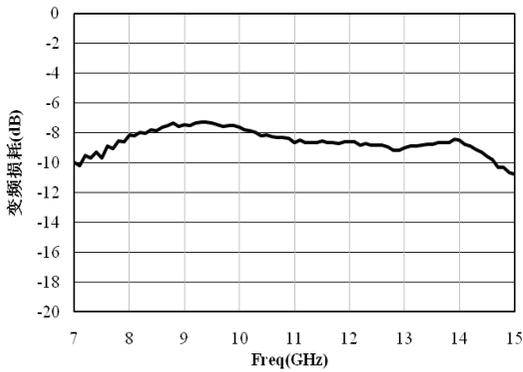
指标	最小值	典型值	最大值	单位
射频频率	8.5-13.5			GHz
本振频率	8.5-13.5			GHz
中频频率	DC-3.5			GHz
变频损耗	7	8	9.5	dB
RF-IF 隔离度	-	35	-	dB
LO-IF 隔离度	-	22	-	dB
LO-RF 隔离度	-	40	-	dB
P1dB(input)	-	14	-	dBm

使用限制参数：

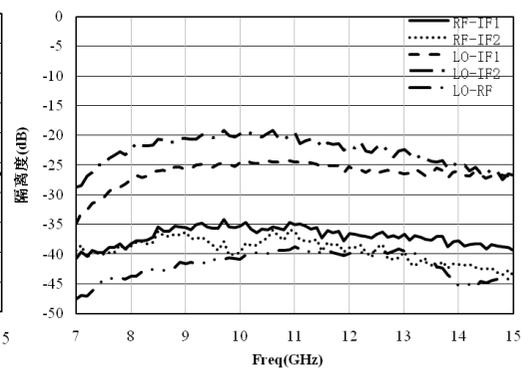
射频/中频功率	20dBm
本振功率	27dBm
存储温度	-65°C-150°C
使用温度	-55°C-85°C

典型曲线：

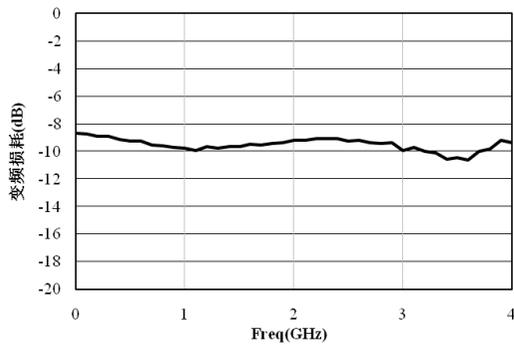
变频损耗曲线@LO=15dBm,中频频率 0.1GHz



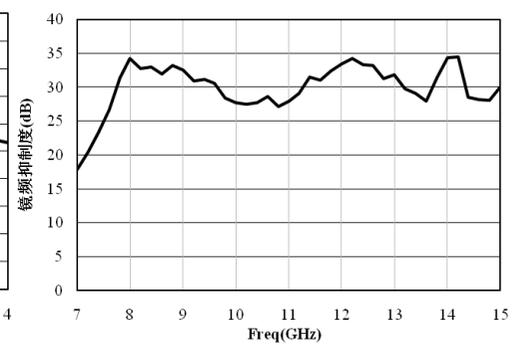
隔离度@LO=15dBm,中频频率 0.1GHz



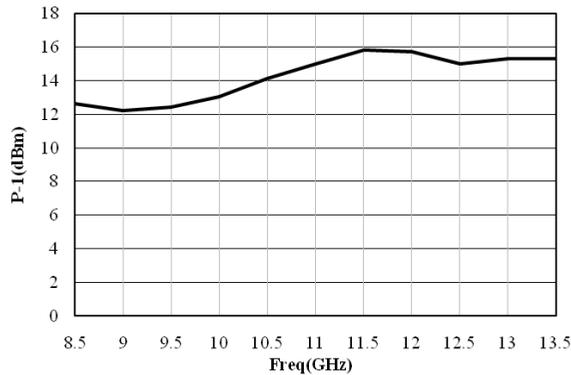
中频带宽@LO=8GHz,LO=15dBm



镜频抑制度

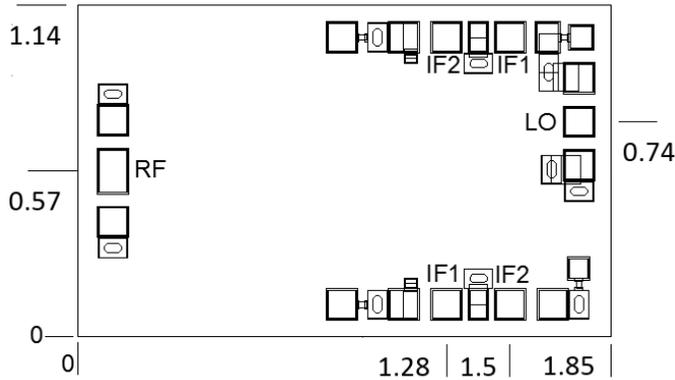


输入 P-1

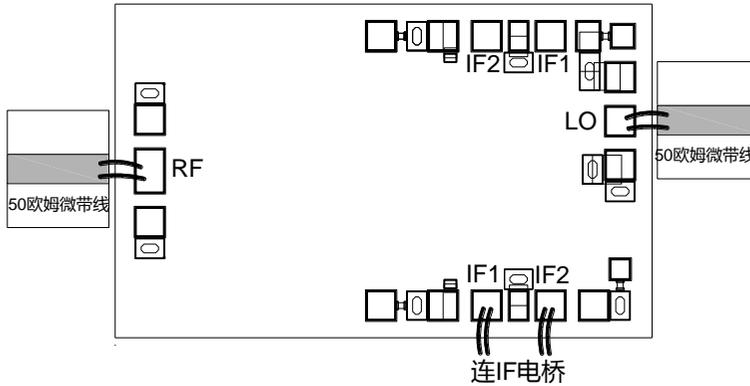


05
混频器

尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。